### LUMINESCENT DEVICE AND DISPLAY DEVICE

Publication number: JP2002151253 (A)

Publication date: 2002-05-24

Inventor(s): YAMAZAKI SHUNPEI; ARAI YASUYUKI +

Applicant(s):

Classification: G09F9/30; H01L27/32; H01L51/50; H05B33/04; H05B33/14; G09F9/30; H01L27/28;

SEMICONDUCTOR ENERGY LAB +

- international:

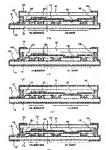
H01L51/50; H05B33/04; H05B33/14; (IPC1-7); G09F9/30; H05B33/04; H05B33/14

Application number: JP20010248422 20010817

Priority number(s): JP20010248422 20010817; JP20000248983 20000818; JP20000259968 20000829

#### Abstract of JP 2002151253 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve moisture resistance of an organic resin substrate to secure reliability of an EL element in addition to the other important factors of a compact size and impact resistance, SOLUTION: Hard carbon film is formed on the surface of an organic resin substrate, to cover an outer face of a sealing material. Typically, a DLC(Diamond-like Carbon) film is used. The DLC film has an SP3 coupling as carbon-carbon bond in short distance order, but has an amorphous structure macroscopically. The DLC film is composed of 95 to 70 atom percent of carbon and 5 to 30 atom percent of hydrogen, very hard and dense, and excellent in gas barrier and insulation property.



Data supplied from the espacenet database --- Worldwide

# (19)日本職許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公別番号 特開2002-151253

(P2002-151253A) (43)公開日 平成14年5月24日(2002.5.24)

| (51) Int.Cl.' 機別和号 |       | 戲別記号 | ΡI            |      | ケーマコート*(参考) |  |
|--------------------|-------|------|---------------|------|-------------|--|
| H05B               | 33/04 |      | H 0 5 B 33/04 |      | 3 K 0 0 7   |  |
| G09F               | 9/30  | 309  | G 0 9 F 9/30  | 309  | 5 C 0 9 4   |  |
|                    |       | 365  |               | 365Z |             |  |
| H 0 5 B            | 33/14 |      | H 0 5 B 33/14 | Λ    |             |  |

#### 審査請求 未請求 請求項の数24 OL (全 22 頁)

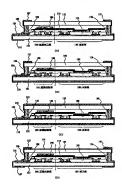
| (21)出願番号    | 特願2001-248422(P2001-248422)  | (71)出顧人 | 000153878           |
|-------------|------------------------------|---------|---------------------|
|             |                              |         | 株式会社半導体エネルギー研究所     |
| (22) 出顧日    | 平成13年8月17日(2001.8.17)        |         | 神奈川県厚木市長谷398番地      |
|             |                              | (72)発明者 | 山崎 舜平               |
| (31)優先権主張番号 | 特願2000-248983 (P2000-248983) |         | 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社 |
| (32)優先日     | 平成12年8月18日(2000.8.18)        |         | 導体エネルギー研究所内         |
| (33)優先権主張国  | 日本 (JP)                      | (72)発明者 | 荒井 康行               |
| (31)優先権主張番号 | 特顧2000-259968 (P2000-259968) |         | 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社 |
| (32)優先日     | 平成12年8月29日(2000, 8, 29)      |         | 導体エネルギー研究所内         |
| (33)優先権主張国  | 日本 (JP)                      |         |                     |
|             |                              |         |                     |
|             |                              |         |                     |
|             |                              |         |                     |

#### 最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 発光装置及び表示装置

#### (57)【要約】

【課題】有機樹脂基板は表示装置の軽量化や耐衝撃性の 向上に対しては非常に有用であるが、EL素子の信頼性 を確保するためには、耐湿性を向上させる必要がある。 【解決手段】硬質の炭素膜を有機樹脂基板表面に形成す る。またシール材の外面を覆うように形成する。代表的 にはDLC (Diamond like Carbon) 膜を用いる。DL C膜は短距離秩序的には炭素間の結合として、SP3結 合をもっているが、マクロ的にはアモルファス状の構造 となっている。DLC膜の組成は炭素が95~70原子 %、水素が5~30原子%であり、非常に硬く緻密であ りガスバリア性と絶縁性に優れている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】第1の電極、第2の電極および前記第1の 電極と前記第2の電極とに挟まれた有機化合物層からな る発光素子を有する発光装置において、前記発光装置の 縁部および側部にはDLC膜が形成されていることを特 後とする発光装置。

[請求明2] 第1の電極、第2の電極はX的前記第1の 電極と前記第2の電極とに挟まれた有機化合物層からな る発光素子を台を発光装置とおいて、耐電発光素子は絶 縁表面を有する第1の基板上に形成され、かつ、シール 材によって第2の基板と振り合きれており、衛生第1 の基板の側部から前記シール材の露出部および前記第2 の基板の側部が上端を と特徴とする界が装置。

[精末明3] 第1の電腦、第2の電極および前配別1の電極と前記が五の電極と能算がよれ有限化合物製の 電極と暗認第2の電極とに映まれた有限化合物製の を表現と集子を含む発光装置において、前記発光等子は絶 縁表頭を有する第1の基度上に形成され、かつ、シール がはよって第2の基板と振り合きれており、前記第1 の基板の側部から前記シール材の露出部および前記第2 の基板の側部はで連続的にDLC膜が設けられており、 前記第1の基板をはよび前記率2の基板と前記DLC膜の 間には、置化膜が設けられていることを特徴とする発光 装置。

【請求項4】請求項3において、前記窒化胰は、窒化珪 素限または、窒化酸化珪素膜であることを特徴とする発 ※装置

【請求項5】請求項3または請求項4において、前記窒化限の胰厚は2~20nmであることを特徴とする発光装置。

【請求項6】請求項1乃至請求項5のいずれか一項において前記DLC膜の膜厚は5~100mであることを特徴とする発光装置。

【請求項1 乃至請求項6のいずれか一項において、第1の基板はガラス基板であって、前記第2の基 成は、有機化合物層から放射された光を透過することを 特徴とする発光装置。

【請求項8】請求項1 乃至請求項7のいずれか一項に記 載された発光装置は、前記第1の電極の端部を覆う隔壁 を有し、前記隔壁は、乾絲剤を混入した樹脂からなるこ とを特徴とする発光装置。

【請求項9】請求項1乃至請求項7のいずれか一項に記載された発光装置は、前記第1の電極の端部を獲う隔壁を有し、前記隔盤上に、樹脂に混入された乾燥剤が設けられていることを特徴とする発光装置。

【請求項10】請求項1万至請求項9のいずれか一項に 記載された前記発光装置を表示部に用いることを特徴と する電子装置。

【請求項11】可撓性を有する有機樹脂材料から成る一 対の基板間に発光素子が設けられた表示装置であって、 前記一対の基板は、端部に設けられたシール材で固定され、該基板の端部及び前記シール材の外面に炭素を主成 分とする被膜が形成されていることを特徴とする表示装 置。

は、 (清水項12] 可挑性を有する有機樹脂材料から成る一 対の基礎制に発光素子が設けられた美元装置であって、 新記一村の基拠は、郷部に設けられたシール材で固定され、 解記一対の基拠の一方の基板の外面と、 前記一対の基板の外面と、 前記一対の 基板の端部と、 前記シール材の外面に 灰素を主成分とす る機度が脱皮されていることを特定とする表で表で (清水項13] 可接性を有する有機樹脂材料から成る一 対の基板側に発光素子が製けられたま一次で、 前記一対の基板は、端部に設けられたシール材で固定され、 前記一対の基板の外面とが 新記一対の基板の外面とが 前記一対の基板の外面とが 前記一対の基板の外面とが 前記一対の基板の外面とが を主張分とする体験が形成されていることを特定と

る表示表置。 【請求項14】発光素子が形成された可視性を有する有 機関脂材料から成る第1の起版と、前直発光素子に対向 して設けられ、可模性を有する有機樹脂材料から成る第 2の基板と、前記第1の基板と前記第2の基板とを空跡 をもって固度するシール材とを由し、新記第1の基板と 前記第2の基板の端部及び、前記シール材の外閣に、炭 業を主成分とする接限が形成されていることを特徴とす 表表示表置。

【請求項15】発光業子が形成されて可能性を有する有機関係材料から成る第10基数と、前記発光等イに対向して設けられ、可強性を有する有機関係材料から成る第20基板と、明記第10基板と計能に第20基板の場合と、前記第10基板が超と、前記第10基板が超と、前記第10基板が加速と、前記が用が成立と、行ないなことを報じても表述が発生。

【請求項16]発光素子が形成された可能性を有する有機関節材料から成る第1つ返放と、前記発光素子に対向 にて設けられ、理解性を有する有限関節材料が会な 2つ基数と、前記第1の基数と前記第2の基数とを空線 をもって固定するシール材とを有し、前記第1の基数と 前記第2の基数の外間と、前記シール材の外間に、炭素 を主成分とする複数が形成されていることを特徴とする 表示装置。

【請求項1.7】 FFTと発光素子とから商素部が形成された可提性を有する有機制能材料がから第10条数 な、商品発光等不以利向して設けられ、可提性を有する 有機関係材料が成る第2の基板と、前記第10基板と 前記第20基板とを整像とも、7配割40基板と 前記第10基板と前記第20基板の外周部及び、 前記シル材の外面に、炭液を主成分とする被酸が形成 されていることを特徴とする表示装置。

【請求項18】TFTと発光素子とから画素部が形成された可撓性を有する有機樹脂材料から成る第1の基板

と、前述形光素下に対向して設けられ、可疑性を有する 有機関新材料から成る第2の基板と、前部第1の基板と 南記第2の基板とを空隙をもって固定するシール材とを 有し、前記第1の基板と前記第2の基板の外周部と、前 記第1の基板の外面と、前記シール材の外面に、炭素を 主成分とする被膜が形成されていることを特徴とする表 示装置。

【語東項19】下下と秀先業子とから商業務が形成されて可報性を有する有機関節材料から成る第1の基数と、助証発光等下に対向して設けられ、可報性を有する有機関所材料から成る第2の基板と、前記第10基板で可能2の基板と整体と、可能で3の上板を大き有し、前記第1の基板と前記第2の基板の外面と、前記第1の基板と前記第2の基板の外面と、対応となる技術をする表表表現

【請求項20】請求項11乃至請求項19のいずれか一項において、前記炭素を主成分とする被膜はSP3結合を有することを特徴とする表示装置。

【請求項21】請求項11乃至請求項19のいずれか一項において、前記炭素を主成分とする被談は、15~25GPaの硬度を有することを特徴とする表示装置。

【請求項22】請求項11乃至請求項19のいずれか一 項において、前記炭素を主成分とする被膜はDLC膜で あることを特徴とする表示装置。

【請求項23】請求項11乃至請求項19のいずれか一項において、前記第2の基板は、前記発光素子のルミネッセンス光を透過することを特徴とする表示装置。 【請求項24】請求項11乃至請求項19のいずれか一項において、前記発光案子は三重項助起子化合物を含む

#### ことを特徴とする表示装置。 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の配する技術分野」な発明は、陽極および陰極から成る一対の電極間に発光性材料を含む薄膜を挟んだ業 を関する。 を対して、発光架子という)を有する設置(以下、発光 装置という)に関する。等に、発光素子にエレクトロル 多キセンス(Electro Luninescence; EL)が得られる 発光性材料(EL材料)からなる複数(以下、光光層と いう)を用いた光法器に関する。また、未売明よ、有 機能指杆を基板とした表示装置に関する。 を形成した表示装置に関する。 での021 で0021

〔従来の技術〕発品やEL材料を用いた表示表面は、従来のCRTと比べ軽量化や薄型化が可能であり、様々な 用途への応用が進かられている。携帯電話や観人向け携 帯型情報端末(Personal Digital Assistant: PD A)などは、インターネットに接続することが可能とな り、映像表示で示される情報量が飛躍的に増え、表示装置にはカラー化や高精細化の要求が高まっている。 [0003]一方、こうした精帯型結構素末に落在する 表示装置は軽量化が重視される。例えば、携帯電話装置 では70度を切る製品が市場に出されている。軽量化の 為には個々の電子部品、筐体、バッテリーなど使用する 殆どの結晶の見直しが図られている。しかし、さらなる 軽量化を実現するためには、表示装置の軽量化も推進す るを要がある。

【0004】多くの場合、表示装置はガラス基板を用いて作製されている。軽量化かためには、このガラス基板の関きを得ぐする方法が考えられる。しかし、それに伴って耐火やすぐなり耐疾撃性が低下してしまう。それは、携帯型情報等はた用いるうとで窓合守な欠点となる。、軽量化や側折散性を同時に消たす手段として、有機樹脂基板(ブラスチック基板)を用いた表示装置の開発が検討されている。

【0005】 E L 材料を用いた発光紫子を有する発光装置の開発が進んでいる。発光紫子で画紫都を形成した表示装置は自発光型であり、液晶表示装置のようにバックライトなどの光源を必要としないので、軽量化や薄型化を実現する手段として有望視されている。

【0006】有機EL材料を用いた典型的な発光素子の 構造を図22に示す。図22において、絶縁体2201 の上には陽極2202、発光層2203および陰極22 04が積層され、発光素子2200を形成している。

【0007】発光層から放射される光2205は陽極2 202を直接透過して観測されるか、もしくは降極22 04で反射された後に陽極22002を遊過して観測される。即かり、観測者2206は発光層2203が発光している画票において陽極2202を透過した発光2205を観測することができる。

【0008】発光率下は、発光層を含む有機化合物層に 正孔を注入する電管、隔積)及び電子を上入する電管 (機積)から形成されており、陽極から注入された正孔 および陰極から注入された電子が、発光層内で再結合す る際に完光する現象を用いている。発光層を含む有機化 台物層は、熱、水分、散等率によって劣化化学 を治療に力を分が表している。 表記の発光がある。 表記の発光がある。 表記の発光がある。 表記の発光がある。 表記の発光がある。 表記の発光がある。 表記の発光が表記が、表記の発光 表置の作業において、新生の発光 表置の作業において、新生の発光 表置の作業において、新生の発光

【0009】そして、発光素子が形成された後、発光素 子が外気に曝されないように発光素子が設けられた第1 の基板と発光素子を封じるための第2の基板とを張り合 わせてシール材などにより封止 (バッケージング) す 2

[0010]尚、本明総書中において、陰極と陽底との 間に設けられるすべての層を総称して有機化合物層と呼 んでいる。有機化合物層の構造は公知の構造に続い、例 えば、正孔注入層、発光器、電子輸送層、または電子往 入層などの積層体を総称して有機化合物層とする。そし する機(合物層)とする。それ れにより発光層においてキャリアの再結合が起こって発 光する。

[0011]ところが発光条子は、耐火性、特に対極化 佐の点で課題があった。有機化合物側に電子を注入させ るために態度として用いられる材料は、仕事関度が低い アルカリ金属。またはアルカリ土類金属が一般的である が、このような金融は、衝撃ませはかかと反応を起こし やすく、酸化されやすいことが知られている。降極の酸 化は、降極として用いる材料から電子が失われるこ を変態する。また、酸化により降極として用いる。 技術と関係性態が吸されてしまう。注入される電 材料の表面に酸化態が形成されてしまう。注入される電 方数の低下や骸化の影響によって、発光輝度の低下が起 ことを考えられている。

#### [0012]

【秀明が解決しようとする問題】上述したように、発光 素不は、ごく僅かな能素や水分によって容易に電極が酸 化されてしまい、多化が標準に起こる。発光業子が酸化 されないようにするための投稿(例2は、能素および水 分を認過しない磁機やガラスで発来子を封止する 職 間を用いて張り合わせる。歴票や不活性ガスを充填する 等、開発がされてきた。しかし、金属や樹脂によって封 止しても、酸素はナラが水機能のを輝は入り込みで、 酸極や果光層を酸化してしまう。さらに、封止に用いる 樹脂も、発光業子からみれば、簡単に水分を通してしまっ つており、ゲークスポットと呼ばれる非発光部が形成さ れ、時間の経過とともに拡大し、発光しなくなる現象が 問題になっている。

【0013】E L 材料は青色条色が可能であり、フルカ
つ表示の自発光温泉示装置を実現させることが可能で
ある。しかし、1 イ機処光素下はは種々の劣化現金が確認
されており、実用化を妨げる該題として解決が急がれて
いる。ゲークスボットは画常経の実践れる非発性の点欠陥
であり、表示品位を著しく低下させるもので知てあり、大
が存在すれば、業子を動待させなくても増加すると言
われている。ゲークスボットの原因は、アルカリ金属を
即れて研究された路板の修化反応であると考えられている。ゲークスボットの原因は、アルカリ金属を
アルマルボットの、アルカリ金属を
データスボットの原生を防止するために、発光素子
を對止して、密接/スキュまたは乾燥料を入れるなどの
手段が振さされているのが現状である。

[0014]また。発光素子は熱にも弱く、熱が敏化を 助長する原因となるなど、酸化に結びつく要因が多いと いった問題が野先洗電を実用化する上で大きな精神となっていた。本発明はこのような問題点を実態し、信頼性 の高い発光装置を提供することを課題とする。そして、 そのような発光装置を表示部として用いることにより表示部の信頼性が高い電子装置を提供することを目的とする。

【0015】ところで、基板に有機樹脂材料を用いた場合、それはガラス材料に比べ水蒸気透過率が高いことが

知られている。例えば、ボリエーテルイミドでは36. 5g/m2 24hr、ボリイミドでは32.7g/m<sup>2</sup> 24hr、 ボリエーテルテレフタレート(PET)では12.1g/m<sup>2</sup> 24hrとかっている。

【0016】従って、有機関脂基板を用いて発光率子を 用いた表示装置を作製して、長期間空気中に放置してお くと、水蒸気が除っに透過して有機発光素子を劣化させ てしまうことは明日である。また、発光素子を封止する シール材も有機側配付利が用いられ、そのシール部分か ら空気中の酸素や水蒸気が浸入することを完全に防ぐこ とば同様である。

【0017】さらに、有機倒衞基板は金属やガラスと比較して柔らかいので、擦り傷などが出来やすいという欠点がある。また、直射日光などを長時間当て続けると、光化学反応により変質し、着色化してしまう欠点があった。

[0018] このように、有機態筋差解は表示破悪の軽量化や耐御弊性の向上に対しては非常に有用であるが、 発光素子の信頼性を確保するためには解決しなければならない。 ない。球態が終している。本発明はこのような問題点 を解決する技術であり、信頼性の高い。現光素子を用いた 表示装置を提供することを目的としている。

[0019]また、発光していない面質では入射した外 そ、発光整置の外部の光)が容極の裏面(有機化含物質 に接する側の面)で反射され、陰極の楽面が減のように 作用して外部の景色が映りこんでしまうという問題を解 状するために、用紙犬フィルとあり付けで、観頭 ないるないた。用紙犬フィルとあり付けで、観り フィルムは、非常に高値であるため製造コストが上がっ てしまうという問題があった。そこで、円備光フィルム を用いばて発光装置の鎖面化を防ぐことを目的とする。 [0020]

【業題を解決するための手段】本発明は、有機関係基板を用いた表示装置において、水蒸気などの浸入を防さ、かつ、表面の傷を助く保護機として、硬質の炭末期を計画を動して、砂点の間には炭素間の結合として、メイヤセンド結合をPP・結合をしたアモルファスルの構造となっている。DLC際の組成は炭素が多り、水素が多つ、30原子%であり、非常に受く絶縁に強んでいる。DLC際の組成は炭素が95~70原子%、水素が5~30原子%であり、非常に受く絶縁に強んでいる。が現在したアモルファンラルフの原子%、木素が5~30原子%であり、非常に受く絶縁に強んでいる。MLで、水素次や機能であれている。MLで、水素次や機能であれている。MLで、水素次や機能であれている。MLで、水素次や機能であれている。MLで、水素次や機能などのガス透過率が低いという特徴がある。また、微少硬度計による構造で、15~250kの硬度を有することが知られている。

【0021】DLC膜はプラズマCVD法、マイクロ波 CVD法、電子サイクロトロン共鳴(ECR)CVD 法、スパッタ法などで形成することができる。いずれの 成腹方法を用いても、有機側筋基板を加熱しなくても、 密着性良くDLC膜を形成することができる。DLCは 基板をカソードに設置して成膜する。または、負のバイ アスを印加して、イオン衝撃をある程度利用して緻密で 硬質な膜を形成できる。

[00022] 成版に用いる反応がスは、液化水素系のが  $\lambda$ 、 例えば $CH_{\rm t}$ 、 $C_{\rm s}H_{\rm s}$   $C_{\rm g}H_{\rm s}$  などを用い、グロー 放電によりイオン化し、負の自己バイアスがかかったカソードにイオンを加速研究をせて成映する。こうすることにより、報管で平常なDLC製を得ることができる。 基板を殆ど加速する最終工程でDLC製を形成することができるができない。 表示装置が完成する最終工程でDLC製を形成することができる。

【0023】DLC限は有機動能基板の少なくとも小交の表面に形成すると、ガスパリア性を高めることかできる。或いは、下下や発光業子が形成された有機制能基板(以下、素子基板という)と、発光業子を対止する対した機を形成してガスパリア性を高める。その場合のDLC限を形成してガスパリア性を高める。その場合のDLC限を形成してガスパリア性を高める。その場合のDLC限の単立はラー500mに形成しておくことにより、美学様を遮断して有機制能基板の光化学反応を抑え、その劣化を防ぐことができる。

【0024】第1の基板をよび第2の基板によって封じられた発光装置の第1の基板の側部からシール村の鑑出 部および第2の基板の側部からシール村の鑑出 連続的に酸素や木分を通さないDLC酸で覆う。こうすることで、従来では端面部外の樹脂を通じて侵入してしまっていた酸素や水分が第1の基板と第2の基板との間 への侵入を防ぐことができる。

【0025] また、発光素干の余化を仰えるために、素 子基板と封止基板とシール料で封止された空隙に空旋列 を設ける。乾燥解は酸化パリウムなどを好適に用いるこ とができる。堀間部分の封止の側部から侵入してしまっ た酸素や水分、または、発光常子自身が有するガスや水 分を吸収させて発光素干圧悪影響を及びさないようにす るために吃燥剤を発光循度以外の場所(例えば、駆動日 形態上解 隔壁上線を大は隔壁化的に設ける。名ちに、 風色の樹脂を有機層間絶縁限に用いることで、発光装置 の鏡面低(映りこみ)の問題を回避する。その他に、シール材形成領域であっても良い。

【0026】このような、DLC膜を設けた表示装置 は、バッシブ型または、アクティブマトリクス型のいず れであっても適用できる。以下、本発明を実施の形態に より詳細に説明する。

#### [0027]

【発明の実施の形態】(実施の形態1)本発明の態様について図1を用いて説明する。図1で示すのは発光素子を 即いた表示装置であり、図1(0)は下FTを用いて駆動回路108と画素部109が形成された素子基板10 1と、封止基板102とがシール村105で固定されて いる状態を示している。素子基板101と対止基板10° 2との間の対止環境内は洗洗業子103が形成され、 を推構116は実施の間配とまた、シー材が形成され、 た近衡に設けられている。または、図示されていない が、商業部109及び開始的25%にあったができた。 が、商業部109及び開始的25%にあった。

【0028】素子基板及び封止基板にはポリイミド、ボリエチレンテレフタレート(PET)、ボリエチレンテンタレート(PET)、ボリエチレンナフタレート(PEN)、ボリエーテルナルンコン(PES)、アラミドなどの有機樹脂材料を用いる。基板の厚さは30~120μm程度のものを採用し、可挽性を持った。

【0029】図1(A)の例では、端部にガスバリア層としDLC限107を形成している。但し、DLC限107を形成している。但し、DLC限10杯部入加端千104には形成されていない。シール材にはエボキシ系接着新が用いられる。DLC限107をシール材105に沿って、かつ、業子基板101と到止基板102の端部に沿って形成することで、この部かから浸透された数を身所でことができる。

【0030】図1(B)は、DLC限110を架子基板 101側と、DLC限107をシール村105に沿っ て、かつ、業子基板101と対止基板102の場部に沿って形成した構成を示している。DLC限は、形成する 即便にもよるが、500m以下の環境光光の透過率が低 下するため、表示側である封止基板102の主英面には 形成しない一段で示している。しかし、FTか形成だされた。 なが、手工基板101頃からか水蒸気の投入を完全に運断 できるので、下FTや発光素子の劣化を防止することが できるので、下FTや発光素子の劣化を防止することが

【0031】図1 (C)はよりガスバリア性を高めた構成であり、茶子基板101 及び封止基板1020全間とシール材105が形成された燃料にかけて、DLC限を全面に形成する例を示している。こうして、ガスバリア性を高か、かつ、基板表面をDLC限で保護して協が付くとと参問いている。

【0032】図1(D)は、業子基板113、封止基板 114に予めDLC膜を形成しておいたものを用いる一 例を示している。そして両方の基板を固定するシール材 が形成される端部にもDLC膜を後から形成する。

【0033】図2はDLC順を形成するためのCVD装置の一個を示している。図2は真空室とそれに付随する 処理手段を中心に示してある。真空盤をその目的例に分 類すると、処理基報218を移動させる影送手段210 が限けるた大装温2202を中心として、当該処理基板に むしし、競を成構する第1の仮定203人収等20以心 を出し入れするロードロック第201、当該処理基板に むしし、脱を成構する第1の仮定203人収等20以心 されている。また、排気手段208、209、211、 212はそれぞれの変字を定場付られている。

【0034】第1の反応室203には、ガス導入手段2

12 放電発生手段213が設けられている。また、第 20反応室204には、同様にガス準入手段215、放 電発生手段216が設けられている。ガス供給手段から は、前途の炭化水素系のガスや、その他にArやHiな どを導入することが可能な構成とする。放電発生手段は 1~120Mにの高周波電源と、各反応室中に設けられ たカツード及びアノードなどから成っている。DLC限 は素板をカツード限に設置して成まする。因1C限 形成するには、素茶基板と封止基板の両面にDLC限を 形成するには、素液を反応させるなどして両面に成膜さ れるようにするを受がある。

【0035】その一例として、第1の反応室203で処理基板の一方の面にDLC膜を形成し、第2の反応室204で他方の面にDLC膜を形成し、第2の反応室の構成を図る場合の反応室の構成を図3を用いて説明する。

【0036】図3(A)は反応数301に、ガス壊入手 段302が接続され、シャワー板309からガスが反応 窓に供給されるアノード306と、高別数電源304が 接続されたカソード305が設けられている。その他に 財気手段303が設けられている。アルシャービン30 7は基数を搬送する際に用いる。このような反応数構 成なにより、処理基板の一方の面と、帰席に入した機能では のでは、が発生をあた。図3(A)で示すようにカ ソードに段差を設けておくと、処理基板の裏面(端部の 近傍)にまでDLCを回り込ませて底使することができる。対 も、この間域に成果を表している。 と、地球とを展れている。

【0037】図3(B)で示す反応室の構成は、図3(A)とは反対側の面、即ち処理基板の裏側にDLC膜を形成する例を示している。反応室310に、ガス導入手段312が接続し、シャワー板320を通して反応室314が接続としたカフード316と、高数234が接続されたカソード315が設けられている。その他に排尿手段313が設けられている。基板314が接続されたカソード315に配売するため、ホルゲー315に配売するため、ホルゲー315に配売するため、ホルゲー319と、それを上下させる機構31が設けられている。処理基板318は最初アシャーピン317上に保持され、ホルゲー319が上昇してカソード315に地理基板がセットされる。こうして、図3(A)とは反対側の面、即ら処理基板の裏側にDLC膜を形成することが可能となる。

[0098]比上のように、図1(A)~(D)で示す 表示装置の構成、即ちガスバリア層としてのDLC膜 は、図2及び図うで説明したプラズマくVD装置により 形成することができる。効節、ここで示す装置の構成は 一例であり、他が様成の成映装を用いて、図1(A)~(D)に示す表示装置を作製しても良い。例えば、D LCを成時するためには、マイクロ映や電でサイクロト ロン共興を用いてくVD装置を適用しても良い。 【0039】DLC膜をガスバリア層として用いること で、水蒸気や酸素が封止頻繁的に浸入することを防ぐ効 果が向上し、発光素子の変定性を高めることができる。 例えば、陰極が酸化して発生するダークスポットを減少 させることができる。

【0040】【実施の形態2】図14(A)(B)は、総 縁表面を有する基板(例えば、ガラス基板、セラミック ス基板、結晶化ガラス基板、金属基板もしくはアラスチ ック基板を用いることができる)に、画素部および駅動 回路を形成する一例を示している。

【0041】図14(A)において、1401はゲート 御駆動回路、1402はソース側(データ側)駆動回 路、1403は御業部である、ゲート側駆動回路140 1およびリース側駆動回路1402に伝達される信号 は、入力配線1404を行わってFワ(フレキシブル プリントサーキット)1405から供給される。

【9042】また、封止基板1406は発光素子を封止 するための基板である。発光素子からの光は上面(対止 基板1406間)に放射されるため、封止基板1406 は透光性を有する必要がある。1407は封止用の封止 基板と素子基板1400とき封止するためり由上附版 である。ここで、図14(A)をA-A'で切削した断 面図を図14(B)に示す。図14(B)において、封 止基板1406次表面に危解素が透過しないようにDL C販で費・ている様子を図示している。

【0043】素子基板1400上に絶縁限1411を形成した後、降極1413、有機化合物層(60発光帯) 4144まとい陽極1413上には保護限1417が設けられている。この保護限1417が設けられている。この保護限1417は、酸素および小により劣化しやすい発光素子1412を限するために設けている。いずれにしても、可視光に対して透明者にくは半週かと後後度であるととが考ましい。

【0044】このとき、陰極1413および陽極141 5は可視光に対して透明もしくは半透明である。なお、 本明細書中において、可視光に対して透明とは可視光の 透過率が概略80~100%であること、可視光に対し て半透明とは可視光の透過率が機略50~80%である ことを指す。陽極1415は、仕事関数が4、5~5、 5の酸化物導電膜を用い、陰極としては、仕事関数2. 0~3.5の導電膜(代表的には、周期表の1族もしく は2族に属する元素を含む金属膜)を用いる必要があ る。ただし、金属膜は、可視光に対して不透明であるこ とが多い。そこで、図14(A)(B)に示すような構 造とすることが好ましい。除板1413は、膜厚が5~ 7 Onm (好ましくは10~30nm)と薄い金属膜と酸化 物導電膜(例えば、ITO)とを積層にして用いている ため、可視光に対して半透明の状態を得られる。尚、有 機化合物層(含む発光層)1414としては、公知の構 造を用いればよい。有機化合物層を単独で用いてもよい し、有機化合物層にキャリア(電子または正孔)注入 層、キャリア輸送層もしくはキャリア阻止層を積層して もよい。

(B) のように封止用樹脂107と樹脂1407とに挟まれた領域1409に設けている。

【0046]図14に示す構造では、免光は縁権を透過 して直接観察者に観察される。外光は、無色制能を用い た有機関間接縁脱1419にほとんど吸収されるため、 問題とならない程度までに低減される。したがって、観 策者には反射光は届かず、外部の景色が観察面に映りこ むといった問題を回避することができる。

【0047】次に、紫子素板1400お上が射止基板1406を明り合わせて作製された発光波響の端間にDL C襲き設ける方法について図15(A)(B)を用いて説明する。発光装着1501は、保持する手段1502には、成果に使用する原料ガスの導入口1508お上が採り口1509が設けられており、反応室1500内には、アラズマを励起させる手段 (F電管)1503が設けられている。保持する手段1502 aは、反応室に固定されており、1502 a上におかれた発光装置の記されており、1502 a上におかれた発光装置の記されており、1502 a上におかれた発光装置の記されており、1502 a上におかれた発光装置の記される。

[0048]電転1503には、(高期後)電影150 58よび整合回路1504が接続されている。電影15 05は代表的には下電影が用いられる。一対の電能1 503には、それぞれ下電源1505が接続され、電 比が即即されるようななっている。下電源1505が接続され、電 たが即かされるようななっている。下電源1500位相を開発して、互いに180°寸れて電船に始称でき るように位相調整計510を設けている。本実施影響 を示した図15(4)では電影が一対設けられて能子を 図示しているが、複数個設けでも、または円飾次の電極 でもよい。

【0049】また、発光装置1501の端面にDLC膜を成膜させるためには膜成長表面にイオン衝撃を与えることが必要であるため、保持する手段1502には電源 1507が接続されており、さらに、セルフバイアスを 生じさせるために電謝1507と保持する手段1502 aとの間にコンデンサー1511を設けている。基板を 様件する手段1502 aは、基板にバイアスを印那させ るための手段、さらに、1502 bは、DLC限が発光 装置1501全間に成膜されないようにするため、発光 領域および外部人が第そ「PPC」が繋けられる形分 でプロして限が成膜されないようにマスクとして設け られている。なお、成膜条件は、実施者が適宜決定すれ げよい。

【0050】素子基板と対止基板が貼り合わされた蛸面 にDLC膜を設けるために、保持する手段1502aの 発光が起こる領域をマスクする部分(以下、発光領域マ スクとする)と外部入力端子をマスウする部分(以下、 外部入力端子マスクとする)とが一部のみつながられた、 状態で設けられている。発光領域マスクシ部入力端子 マスクとをつなく部分の4個(図15(B)参照)は、5 mu以下になるようにするのが好ましい。また、保持手段 1502bの高さ(図15(B)参照)との関係が、高 さ/幅22間に定なるようにするのが好ましい。

【0051】発光領域マスクと外部入り増予マスクとか ななる保持手段以外にも、通常、CVD装置でマスキン グテープで外部入力増予部かを覆うことでDLC限が成 腰されないようにしてもよい、発光素下の酸素および水 分による外化を防ぐには、発光装置1501の4ヶ所の 確面にDLC際の成割せる必要がある。DLC際の成 腰を効率よく均一に行うために、保持する手段1502 aを支える1506に回転する機能が付加されていても よい。

【0052】保持する手段1502aは発光装置150 1に負の自己バイアスを印加するための電極も兼たている、電極1502aには、電影1507により負の三には、電影1507により見つことがしている。 に成即し、観音のしこ便を設めることができまり501の場面に成即し、観音のしこ便を設めることができまり501の場面に成即し、観音のしこ度を対してとなった。 なお、原料ガスとしては、炭化水素、例えばメタン、エタン、プロバン、ブタン等の不軽和度化水素、もしくは、 メゼン、トルエン等の芳香原系を用いてばよい、こと、炭化水素が子のうち1個もしくは複数側がF、C1、B 下等のハロゲン系元素に置き換わったハロゲン化炭化水素を用いてもは、まを用いてもは、

【0053】以上のようにして、発光波震の端面を響う ように厚さう~100m( 好ましくは10~30m) の DLC原1510を成勝する。図23に、本売別の成膜 装置を用いて発光装置にDLC膜が設けられた様子を示 す。本実施形態では基板の検密および開密に直接DLC 膜を設けた例を示したが、より密着性をあげるために、 DLC服を設ける前に繁化膜(例えば、窒化珪素限また は窒化紙化生素膜)を下地膜として設けてもよい。その 際、聚化版の原理は2~20mとすたばよい。

[0054]

【実施例】[実施例1]本発明は発光素子を用いたあらゆ る表示装置に適用することができる。 図4はその一例で あり、TFTを用いて作製されるアクティブマトリクス 型の表示装置の例を示す。TFTはチャネル形成領域を 形成する半導体膜の材質により、アモルファスシリコン TFTやポリシリコンTFTと区別されることがある が、本発明はそのどちらにも適用することができる。 【0055】有機樹脂基板は、現在市場に供給されてい る材料の中で450℃以上の熱処理に耐えるものはな い。しかし、レーザーアニール技術を使えば、基板加熱 温度が300℃以下でもポリシリコンTFTを作製する ことが可能となる。また、ポリシリコンTFTの製造プ ロセスでは、水素化処理がしばしば必要とされるが、こ れはプラズマを援用した水素化処理を行うことで、20 ○℃程度の基板温度でもその効果を得ることができる。 【0056】図4では駆動回路部450にnチャネル型 TFT452とpチャネル型TFT453が形成され、 画素部451にスイッチング用TFT454、電流制御 用TFT455が形成されている様子を示している。こ れらのTFTは、鳥状半導体層403~406、ゲート 絶縁膜407、ゲート電極408~411などを用いて 形成されている。

[00 57] 基版 40 1 はポリイミド、ポリエチレンテレフタレート (PET)、ポリエテルナルフォン(PES)、アラミドなどの有機関配杆科を用いる。そして、30~12 0 μs、代表的には75 μsの浮さの基板を用いる。プロテング層 40 2 は基板 40 1 からオリゴマーなどが折出しないように、酸化塑化シリコン(SiO,N,で表される)、整化シリコン協などを50~20 nsの厚さに 形成して設ける。関節経験別まどを50~20 nsの厚さに が成して設ける。関節経験別は20 リコンなどで形成される無機総様似 41 8 と、アクリルまだはポリイミドなどで形成される有機能疑例 41 9 とから成っている

【0058】駆動回路部450の回路構成は、ゲート信 今側駆動回路とデータ信号側駆動回路とで異なるがここ では省略する。nチャネル型TFT452及びpチャネ ル型TFT453には記線412、413が接続され、 これらのTFTを用いて、シフトレジスタやラッチ回 路、バッファ回路などが形成される。

【0059】画系第451では、データ配線414パイ ペッチング用下F745ペのソース側に接続し、ドレイ というでは、15は電流制御用下F7455のゲート電 6411と接続している。また、電流制御用下F745 5のソース機は高張地路経線417と接続し、ドレイン 側の電線416が発光業子の陽極と接続するように配線 されている。図5はこのような画素の上面図を示し、便 宜上図4と共通する符号を用いて示している。また、図 5において、A−A・線に対所する断面が図4において 示されている。 【0060】そして、図4に示すように、これら魔線を 覆いまた。アクリルやボリイミドなどの有機関節、対策 には逸光性の有機関節を用いて簡単420、421かの 成される。発光素子456は、ITO(酸化インジウム スズ)で形成される陽極422、発性性料をできる 機化合物関423、MgAgをしまでなどの材料を用いて 形成される際始42とから成っている。開催42 の、421は、配格42の場合を受えまに形成さ れ、この部分で除電と降極とがショートすることを防ぐ かはい野ける。

【0061】有機化合物層を形成する材料は、低分子系 材料または磁分子系材料のどちらであっても構わない。 低分子系材料を用いる場合は蒸着法を用いるが、高分子 系材料を用いる場合はスピンコート法や印刷法またはイ ンクジェット注かどを用いる。

【0062】高ケ子系材料では、水土投水リマー材料な どが知られている。その代表側は結晶質半導体標が、ラフ ェニレンビニレン(PPV)系、ボリビニルカルバゲール(PVK)系、ボリフルオレン系などが上げられる。 虚のような材料を肝いて那後される有能へ含物質に 是際又は積層構造で用いられるが、積層構造で用いた方が 発光物単は良い。一般的には薄極上に正孔上列。正孔 輸送層 (光光層) 電子輸送層、または正孔上列。正孔 輸送層 (光光層) 電子輸送層、または正社上列。正孔 他送層 (光光層) 電子輸送層、または正社上列。正孔 他送層 (光光層) 電子輸送層、対なは正社人層。正孔 でも良い、本規則では公知のいずれの構造を用いても良いし、有機化合物層に対して蛍光性色素等をドーピング しても移い。

【0063】代表的な材料としては、例えば、以下の米 四特許又は公開公報に開示された材料を用いることがで きる、米国特許第4,750,429号、米田特許第4,769,229号、 米田特許第4,720,422号、米田特計第4,959,959号、米田 特許路5,079,465号、米田特計第4,959,959号、米田 特許路5,079,466号、米田特計第5,507,637号、米田特計第5, 506,1617号、米田特計第5,509,862号、米田特計第5,294, 869号、米田特計第5,509,862号、米田特計第5,294, 869号、米田特計第5,509、米田特計第5,294 778日、59号、米田特計第5,294,870号、特開干10-1895 25号受税、特開平8-2410489分級、特開平8 78159分級係、

[0064] 前、カラー表示には大別して四つの方式が あり、R(赤)G(縁)B(青)に対応した三種類の充 光素子を形成する方式、白色光光の発光素子とカラフィルターを組み合わせた方式、青色又は背縁発光の発光 素子と要洗体(強光性の色変薄層:CCM)とを組み合 わせた方式、路径(対向電径)に透明弦を使用してR GBに対応した発光素子を重ねる方式がある。

[0065] 具体的な有機化合物層としては、赤色に発 光する有機化合物層にはシアノボリフェニレン、緑色に 発光する有機化合物層にはボリフェニレンビニレン、 色に発光する有機化合物層にはボリフェニレンビニレン またはポリアルキルフェニレンを用いれば良い。有機化合物層の厚さは30~150mとすれば良い。

[0066]上記の例は発光限として用いることのできる有機EL材料の一例であり、これに限定されるものではない、発光層、電荷輸送層、電荷性入層を形成するための材料は、その可能な組合せにおいて自由に選択することができる。本実施例で示す有機化合物層は、発光層とPEDOT(ボリチオフェン)またはPAn1(ボリアニリン)から成る正孔注入層を設けた構造をする。
[0067]有機化合物層 23の分には遺跡値 24が 設けられる、陰極 24としては、仕事関数の小さいマグネシウム(Mg)、リチウム(Li)若しくは水ルシウム(Ca)を含む材料を用いる。存ましてはて強力を(MgとAgをMs・Ag=10:1で混合した材料)

[0068] 陰極424は有機化合物間423を形成した後、大気解放しないで減速的りに形成することが望ました。 陰極424年機化合物間423との界面地壁は発光票子の発光効率に大きく影響するからである。なお、本明議権中では、陽低「陽和電節」、有機化合物間及び陰極下級される発光票子を受光素手を呼ぶ。

でなる電極を用いれば良い。他にもMgAgAl電極、

LiA1電極、また、LiFA1電極が挙げられる。

[0069] 有機化合物層 423と酸陸424とでなる 概層体は、各画素で個別に形成する必要があるが、有機 化合物層 423は水外に懸かて弱いため、通常のフォト リソグラフィ技術を用いることができない、また、アル カリ金属を用いて作製される陰極 424は容易に酸化さ 材でしまり、従って、メタルマスク等の物理的なマスク 材を用い、真空素者法、スパック法、アラズマCVD法 等の気相法で選択的に形成することが写ましい。なお、 有機企物層を置的体形成することが写ましい。なお、 大規企物層を置的体形成する方法として、42クグ ェット法やスクリーン印刷法等を用いることも可能であ るが、これらは現代では酸の)連続的成ができないの で、上述の方法が終ましいと言な。 、上述の方法が終ましいと言な。

【0071】図4ではスイッチング用TFT454をマルチゲート構造とし、電流制御用TFT455にはゲート電極とオーバーラップするLDDを設けている。ポリ

シリコンを用いたTFTは、高い動作速度を示すが故に ホットキャリア法人を少か発化も起こりやすい、そのため、図2のように、産かの十分に低いて、機能に低して構造 関本るTFT(イライ電流の十分に低いスイッチング用T FTと、ホットキャリア法人に強い電流制御用下FT) を形成することは、高い信頼性を有し、且つ、足好な面 像表示が可能な、場外性能の高い)表示装置を作別する セルサルビールをいると

上で非常に有効である。 【0072】図6はこのような表示装置の外観を示す図 である。画像を表示する方向は発光素子の構成によって 異なるが、ここでは上方に光が放射して表示が成され る。図6で示す構成は、TFTを用いて駆動回路部60 4、605及び画素部603が形成された素子基板60 1と封止基板602がシール材610により貼り合わさ れている。素子基板601の端には、入力端子608が 設けられこの部分でFPCが接続される。入力端子60 8には外部回路から画像データ信号や各種タイミング信 号及び電源を入力する端子が500 μmピッチで設けら れている。そして、配線609で駆動回路部と接続され ている。また、必要に応じてCPU、メモリーなどを形 成したICチップ607がCOG (Chip on Glass) 法 などにより素子基板601に実装されていても良い。 【0073】端部にはDLC障611が形成されシール 部分から水蒸気や酸素などが浸入し、発光素子が劣化す ることを防いでいる。素子基板601や封止基板602 に有機樹脂材料を用いる場合には、図1を用いて説明し たように、入力端子部を省く全面にDLC膜が形成され ていても良い。DLC膝を成勝するとき、入力端子部は マスキングテープやシャドーマスクを用いて、予め被覆

【0074】入力増子は図7で示すように、チタン(T1)とアルミーウム(A1)とから成る配施705と陽 極をヒア形成した「T0706とを構図して形成した。 でする。 一般に、大力増子部におけるC一で線に対 広ったも、図8は、入力増子部におけるC一で線に対 702はシールギ703で貼り合わされており、その端部には素子基板701と対止基板702にかけてりして 70704が形成されている。原始704が形成されている。原始704が形成されている。原格708年209上に形成されるが、廃稿708を記録とコンタクトさせるため原示するか、廃稿708を記録とコンタクトさせるため原示するよう会コンタクト都710を受けている。

しておけば良い。

【0075】このような有機制能基板を用いた表示表置 において、DLC膜を形成することにより発光素子の劣 化を削ぎ、表示表置の長期時で安定性を確保することが できる、特に、有機制能基板を用いた表示表置は排帯機 器の表示装置として好適に用いることが可能であるが、 当該機器が展現で使用される場合には、直射日光空間 にさらされる場合も想定して信頼性が喫求される。こう した場合にもDLCを設けることで信頼性を向上させる ことができる。

【0077】図9(A)は隔壁421の中に乾燥剤48 0を分散させて設けた例である。隔壁421は熱硬化型 または感光性の有機倒脂材料で形成する。このとき、重 合する前の有機倒脂材料中に乾燥剤を分散させておき、 そのまま粧形板する。

【0078】図9(B)は有機樹脂絶線側419上に乾燥剤481を形成する例を示す、この場合、乾燥剤は真空素着性や印刷法を用いて防定の場所に所定のからで素着性や印刷法を用いて防定のがこれに隔壁421を形成する。 【0079】図9(C)は隔壁421の上に乾燥剤482を形成する例を示す。酸燥剤482は同様に真空薫着性や印刷法により形成する。

[0080] 図9 (A) ~ (C) で示す方法は乾燥剤を 設ける一例を示し、これらを適宜組み金化干が成して 良良い。また、図1に示す構成に本実施例の構成を組み 合わせても良い。そして、こうした乾燥剤の設置方法を 実施例1で示す表示装置に適用すれば、DLC脚のガス バリア性と相まってより信頼性の高い表示装置を完成さ せることができる。

【0081】(実施例3)図10は逆スタガ型のTFTを 用いた表示装置の一例を示す。使用する基板501や発 光素子556は実施例1と同様な構成であり、ここでは その説明を省略する。

【0082】 速スタガ型の下下は、表板501機から ゲトを整ち08~511、ゲート総業数507半導体 限503~506の順に形成されている。図10におい て、駅勢間路部550にカキャネル型下下7552とp チャネル型下下553が振成され、画業部5515 大火が用下下753が振成され、画業部5515 大光業子7556が形成されている。周間絶縁熱以盆化シ リコン、酸化型化シリコンなどで形成される無絶縁観 518と、アタリルまはオリイミドなどで形成される 電機断能数519とから扱っている。

【0083】駅勅回路部550の回路構成は、ゲート信 今側駅勅回路とデータ信号側駅動回路とで異なるがここ では省監する。nチャネル型TFT552及びpチャネ ル型TFT553には配線512、513が販続され、 これらのTFTを用いて、シフトレジスタやラッチ回 路、バッファ回路などが形成される。

【0084】画素部551では、データ配線514がス

イッチング用下F下554のソース限に接続し、ドレイン側の配線515は電流制御用下F下55のゲート電 を511と接続している。また、電流網網用下F下55 5のソース側は電源供給配線517と接続し、ドレイン 側の電格516分発光業子の降径と接続するように配線 されている。

【0085】そして、これら配線を覆うようにアクリルやポリイミドなどの有機問題、好趣には感光性の有機問題を用いて隔壁520、521が形成される。発光素子556は、170(酸化インジウム・スズ)で残成される陽能522、有機Eし材料を用いて作製される有機化合物層523、MgAgやL1Fなどの材料を用いて形成される路径524とから成っている。隔壁524とから成っている。隔壁522は、隔極522の婚部を置うように形成され、この部分で発極と陽低とがショートすることを防ぐたかに設ける。

【0086】その他、下午下の構造を省けば、画業部の 構成。成び表示端面の構成は実施例、上四階な特成とな る。ポリシリコンを用いた速スクが型ド下では、アイ ファスシリコン下下で「通常は速スタが型ド下でで形成 される)の製造ラインを演用して作業できるという利点 がある。勿論、エキシマレーザーを用いたレーザーアニ ール技術を使えば、300℃以下のプロセス温度でもポ リシリコンドアドが件軽削能なか

[0087] (集権例4]実施例1で示す表示装置を用いた電子装置の構成例について図11を用いて説明する。 図11の表示装置900は、基板上に貯成されたで下ではよって画業920から成る画業部921、画業部の総を用いるデータ信号側駆動回路915、ゲート信号側駆動回路914がデシル根動の何を示しているが、シフトレジス9916、ツッチ回路917918、バッファロ路919から成っている。また、ゲート信号側駆動回路919から成っている。また、ゲート信号側駆動回路914であり、シフトレジスタ、バッファ等(いずれも区示せず)を有している。

はかに、リアヤリンは、VGAの場合には640 ×480(横×蟹)の両まを有し、図4または図5で記 明したように、各画家にはスイッチング用下下1分で 電流物即用下下が配置されている。発光素子の動作 は、ゲート配腸が選択されるとスイッチング用下下下の ゲートが開き、ソース配腸が一角信勢がコンデット に落積され、電流制御用下下でが一トが開く。つま り、ソース配腸がら入力されるデータ信号により電流制 脚用下下下に流流対像用と下が発生する。

【0089】図11で示すシステムブロック図は、PD Aなどの携帯型情報端末の形態を示すものである。実施 例1で示す表示装置には画茶部921、ゲート信号側駆 動回路914、データ信号側駆動回路915が形成され ている

【0090】この表示装置に接続する外部回路の構成

は、安定化電源と高速高階度のオペアンプからなる電源 回路901、USB端子などを備えた外部インターフ イスボート902、CPU903、入力手段として用い るペン入力タブレット910及び検出回路911、クロ ック信号発展器912、コントロール回路913などか ら成っている。

【0091】CPU903は映像信号処理回路904やベン入力タブレット910からの信号を入力するタブレットインターフェイス905などが内蔵されている。また、VRAM906、DRAM907、フラッシュメモリ908及びメモリーカード90分形後式されている。CPU903で処理された情報は、映像信号/データ信号)として映像信号処理回路904からコントロール関係8913に出力する。コントロール回答913は、映像信号/グロックを、データ信号側駆動回路915とゲート信号側駆動回路914かられているなくな異なる機能を参与ている。

【0092】具体的には、映像信号を表示装置の各画素 に対応したデータに振り分ける機能と、外部から入力さ れる水平同期信号及び垂直同期信号を、駆動回路のスタ ート信号及び内蔵電源回路の交流化のタイミング制御信 号に変換する機能を持っている。

[0093] PDAなどの携帯型情報製ははACコンセントに接続しなくても、充電型のバッテリーを電源として歴外や電車の中などでも、終時間使用できることが望まれている。また、このような電子装置は持ち流び易さを重点において、軽量化と小型化が同時に要求されている。電子装置の重量の大半を占めるバッテリーは、容量を大きぐすると重量増加してしまう。後って、このような電子整面で開発した低減さなかに、バックイクの点灯時間を制算したり、スタンバイモードを設定したりといった、ソフトウエア面からの対策も施す必要がある。

【0094】例えば、CPU903に対して一定時間ペン入力タブレット910からの入力信号がタブレットインターフェイス905に入らない場合、スタンバイモードとかり、図11において点線で囲んだ部分の動作を同期させて停止させる。表示装置では浸光第テの発光接度を減衰させるか、映像の表示そのものを止める。または、各審案にメモリーを備えておき、静止画像の表示モードに切り替えるなどの処理をとる。こうして、電子装置の消費電力を拡送させる。

[0095]また、静止画像を表示するにはCPU90 3の映像信号処理回路904、VRAM906の定分 機能を弾止させ、清理電かの低速を図ることができる。 図11では動作をおこなう部分を点線で表示してある。 また、コントーロラー913は、図6で示すように、I Cチップを用い、COG法で楽子基板に装着してもよい し、表示装置内部に一体形成してもよい。

【0096】本発明の有機樹脂基板を用いた表示装置

は、第千条置の軽量化に関節することができる。例えば、5インチクラスの表示装置を搭載することを考える と、ガラス基級を用いるとその重量が60g程度になるのに対し、本売9の40種間路基板を用いた表示装置では 10g以下を達成することができる。さらに、DLいまでは がコーティングをれていることで、表面の硬度が増し、 いわゆるいっかを傷などが出来にくく、いつまでも美しい は、携帯型情報集末をどの電子装置においてき木かて優 は、携帯型情報集末をどの電子装置においてき木かて優 なた効果を発度できる。

【0097】[実施例5]本実施例では、発光素子の陰極 を形成する方法について説明する。図16において、絶 緑膜1601の上には、第1の電極として陽極160 2、有機化合物層1603、第2の電極として陰極16 0.4 ならびにDLC膜1605が精層されている。 【0098】図16(A)について説明する。絶縁膜1 601として酸化珪素膜を用い、陽極1602として は、酸化亜鉛に酸化ガリウムを添加した酸化物導電膜 (膜厚120mm)を用い、有機化合物層1603として 20nm厚の銅フタロシアニン(正孔注入層)と50nm厚 のA 1 q2 (アルミキノリラト錯体: 発光層) との積層 膜を用いている。また、陰極1604は、極薄く成膜さ れた金属膜を半透明電極1604aと透明電極1604 bとを積層した構造にしてもよい。例えば、半透明電極 1604aとして20m厚のMgAg膜(マグネシウム と銀とを共蒸着した合金膜)を用い、透明電極1604 bとして酸化亜鉛に酸化ガリウムを添加した膜厚200 nmの酸化物邁電膜を用い、保護膜1605としてDLC 膜を用いて形成している。

【0099】また、図16(B)は、純緑原1601上 に、陽極1602、有機化治物層1603、電子能力に としてよ1序かなる図1606を設けて、その上級 化亜鉛に酸化ガリウムを添加した膜厚200maの酸化物 場電膜からなる酸極1604、DLC膜からなる保護原 1605を終版している。

【0100】図16(C)は、絶縁膜1601上に、陽 極1602、有機化合物関1603、有機化合物関上に 正字注入層として15からな別1606を設け、そ の機能毎1604として50m以下(好ましくは、20 m1)の厚きのM & A & (マグキシウムと競とを主寒者し た合金膜)からな半時間電路 [604 a および形化亜 鉛に酸化ガリウムを添加した原厚200mの機化物等電 限からな透明電路1604 b と 保護則160 をとしてり上の原を用いて解成している。

【0101】上記のような構造の発光素子を作ったあ と、発光素子を封止して、発明の実施の形態で述べたよ うな方法で、端面にDLC膜を成膜して、酸素および水 分による劣化を防止する。

【0102】[実施例6]本実施例では、実施例1とは異なる発光素子の陰極を形成する方法を図17を用いて説

明する、図17(A)は、純純酸1701上に、仕事関数の小さいアルカリ金属、例えばし; 以はMgからなる 陰極1702を設け、有機化合物層1703、陽極17 04および保護膜1705としてDLC限を形成する。 [0103]図17(B)は、純純酸1701上に、透 明導電膜1707形成される透明電極1702とを指 い(服厚50m以下)金属膜(例えば、A1-Li合金 しくはMg A5金金)からな手端明電低1702と 種類日、陰極1702を形成する。その上に有機化合 物層1703、陽極1704および保護膜1705とし でDLC機を形成する。

[0104] (実施例下)未来施門では、有機化合物層の 具体的な一実施例について説明する。従って、本実施例 は、影明の実施の秘密および実施例1-6のいずれの構 成とも組み合かせることが可能である。なお、本実施例 において、第1の電極の陽奄1801としては酸化物等 電限を用いてはばい、また、第2の電電の機能として は、図18を用いて説明した構成の跡電膜を用いればよい。

【0105】図18 (A) は、開極1801の上に正孔 注入層1802、正孔輸送層1803、発光層180 4、電子輸送層1805、電子往入層1806を積層 し、その上に瞭極1807を形成した何である。図18 (B) は、陽極1801の上に正孔注入層1802、発 光層1804、電子輸送層1805、電子注入層1802、発 のよ、また、図18 (C) は陽極1807を形成した何であ あ、また、図18 (C) は陽極1807を形成した何であ 周1802、発光層1804を積層し、さらに電子注入 層1806を形成し、その上に除極1807を形成した 例である。さらに 図18 (D) は陽極1807を形成した 例である。さらに 図18 (D) は陽極1807を形成した 所である。さらに 図18 (D) は陽極1803、発光層18 04を病慮し、その上に除極1807を形成した例である。

【0106】以上の構成は、一実施例であり、本発明に 用いることのできる有機化合物層の構造はこれに限定さ れるものではない。本実施例で示す有機化合物層の態様 は、実施例1~6に組み合わせて適用することができ ス

【0107】(実施例8)発光装置の端間に成機されたD し、限に加えて、さらに確保および水分からの劣化を助 ぐかなに発光等で向ないを受ける方法にいて 図10を用いて説明する、1901は第1の基板となる ガラス基板であり、基板上には、下地絶縁膜1902が 設けられている。また、下地絶縁膜1902と止非晶質 シリコン機を形成し、公知の技術により結晶化して結晶 セシリコン膜とし、この結晶性シリコン膜を急級にバタ ーニングして各下下の活性層190名を形成する。 【0108】各倍性順上には、ゲート絶縁膜(図示せ リー・ゲート電解6905、開始後練間1906。およ

び、仕事関数の低いアルカリ金属またはアルカリ土類金

風からなる闘楽電極(第10電磁)1907が続ける 水、両業電極1907上には有機化合物層1908、有 機化合物層1908上には接性インジウムと酸化スズと の化合物からなる酸化物導電膜(本実施例では、1TO 限)からなる陽極(第20電池)1909が設けられて いる。

【0109】さらに、各TFTを覆うように、有機化合物層の下の層に隔壁1910を設けている。ここで、乾燥剤を混ぜた樹脂を隔壁の材料に用いれば、保護膜191より下層に存在する水分を吸収することができ、発光素子の劣化を防ぐことができる。

[0110] その他の例として、図19(8)に示した ように、駆動回路の関係の保護際1911上に、乾燥剤 を混ぜで樹脂(以下、乾燥料という)1912を設けて もよい、この乾燥剤1912は、スペーナとしての機 能も有している、なお、乾燥剤1912を配置する場所 は、大力配線の上。まなは調薬活の免光を変材しない 領域のいずれでもよく、さらに組み合わせて設けてもよ い、未実施例は、実施例1~7のいずれかの構成と組み そわせてもよい。

【0111】(実施例9)第1の基板(ガラス基板等)2 001上に、発光無子を形成する第3の基板(フィルム 状の基板、例えばプラスチックフィルルやごく振りステ ンレスの基板)2004を貼り付けて、発光素予形成 後、第3の基板2004と貼り付けて、発光素予形成 6次、第3の基板2004と貼りではで、セントです。または最 品を使って剥離して、ガラス基板2001を止りずまたは最 またついて 図20を用いて割回する。

[0112] 第2の基板2003によって、第3の基板 2004上に形成された発光業子が到じられたら、ガラ 2種数2010英国からレーザー光を照射して接着層 (例えば、ポリイミド、ポリアミド、ポリスミドアミ ド、ウレタが間が、光硬化性樹脂、炭砂化水砂脂、 アクリル系接着剤。 位化ビエル樹脂、エポキシ樹脂、アクリル系接着剤。 ム系接着剤等)2002を気化させるなどして、ガラス 基板2001を分離する。 本実施例では、アスロレーザーの脚2高調板 (接長532mm) を用いて線状ビームを 形成し、ガラス基板2001を活過させて接着層200 2に照射させて接着層2002を気化させて、ガラス基板 板2001を増加している。

【0113】ガラス基板を制がことで、アラスキック フィルム基板や得い金属基板を基板とすることで、軽量 化、薄壁化が配するともも可損性を有する形式装置を 得ることができる。尚、第1の基板2001上に接着層 2002を設けた後、第3の基板2004上と脱り合わせ も、第3の基板2001と貼り合わせても、どちらでもよ い、未実施開は、発明の実施の形態、よどちらでもよ い、本実施開ば、発明の実施の形態、よどは実施別1~ 80いずれかと組み合わせて用いることができる。

【0114】[実施例10]本実施例では、有機化合物層

として - 亜項励起子(シングレット)により発光する有 機化合物(以下、シングレット化合物という)および手 ・ 重項励起子(トリプレット)により発化する有機化合物 (以下、トリプレット化合物という)を併用する例につ いて限明する。なお、シングレット化合物とは一・亜項動 起のみを辞由して発光する化合物を指し、トリプレット 化合物(は三重項励起を経由して発光する化合物を指 す。

y.

(0 115] トリプレット化合物は、としては以下の論
文に記憶の有機化合物が代表的な材料として特針され

る。(1) T. Tsutsui, C. Adachi, S. Saito, Photoch
enical Processes in Organized Molecular Systems, e

d. K. Bonda, (Elsevier Sci. Pub., Tokyo, 1991) p. 43

7. (2) M. A. Baldo, D. F. O'Brien, Y. You, A. Sho
ustikov, S. Sibley, M. E. Thompson, S. R. Forrest,
Nature 395 (1998) p. 151. この指文には次の式で示され
たる有機化合物が開示されている。(3) M. A. Boldo, S. Leansky, P. E. Burrrows, M. E. Thompson, S.
R. Forrest, Appl. Phys. Lett., 75 (1999) p. 4. (4) T.
Tsutsui, M. -J. Yang, M. Yahiro, K. Nakaure, V.
atanabe, T. tsuji, Y. Fukuda, T. Makimoto, S. Maya
guchi, Jpn. Appl. Phys., 138 (1228) (1999) L1502.

[0 116] また、上記憶文に記載される光化性材料だ

[0 116] また、上記憶文に記載される光化性材料だ

けでなく、次の分子式で表される発光性材料(具体的に は金属錯体もしくは有機化合物)を用いることが可能で あると考えている。

[0117]

【化1】

(式中、ビ t はモチル益、 Mは周港表の8~10族に属する元素を表す)

【0118】 【化2】

(式中、Mは周期表の8~10歳に属する元森を表す)

【0119】上記分子式において、Mは周期表の8~1 の核に似する元素である。上記論文では、白金、イリジ ウムが用いられている。また、本発明者はニッケル、コ バルトもしくはパラジウムは、白金やイリジウムに比べ で好直であるため、発光装置の製造コストを低減する上 で存ましいと考えている。特化、ニッケルは副核を形成 しやすいため生産性も高く好ましいと考えられる。 「0120】上記トリアレット化合物は、シングレット 化合物よりも発光効率が高く、同し発光環度を得るにも 動作電圧「発光素子を発光させるに要する電圧)を低す を高とが可能では、今は

【0121】低分子の有機化合物を発光層として用いる 場合、現状では赤色に発光する発光層の寿命が他の色に 発光する発光層とりも知い、これは発光効率が他の色よ りも劣るため、他の色と同じ発光層度を得るためには動 作地圧を高く酸性しなければならず、その分劣化の進行 も思いためである。

【0122】 「かしながら、本実施同では赤色に発光する発光量として発光効率の高いトリプレット 化合物を用いているため、緑色に発光する発光間や青色に発光する発光間と有光光を発光のとが可能である。後で、赤色に発光する発光のとが下盤である。とつて前になるとなっます。という、からないできるとなった。とが可能となる。また、動作電圧にカラー県共を行うことが可能となる。また、動作電圧のインジンを低く観えることができることは、トランジスタの耐圧のマージンを低く観えているため、

【0123】なお、本実施例では、赤色に発光する発光 層としてトリプレット化合物を用いた例を示している が、さらに緑色に発光する発光層もしくは青色に発光す る発光層にトリプレット化合物を用いることも可能であ

[0124] RGBカラー表示をする場合には、画業部 に赤色に発光する発光業子、終色に発せする発光業子、 特色に発光する発光業子を設ける必要がある。この場 合、赤色に発光する発光素子にトリアレット化合物を用 い、その他はシングレット化合物を用いて形成すること も可能である。

【0125】こうしてトリプレット化合物とシングレット化合物を使い分けることでそれぞれの発光素子の動作 電圧をすべて同一(10V以下、好ましくは3~10

V)とすることが可能となる。従って、発光装置に必要な電源を例えば3Vもしくは5Vで統一することができるため、回路設計が容易となる利点がある。なお、本実施例の構成は、実施例1~6のいずれの構成とも組み合わせて実施することが可能できる。

【0126】(実施例11)本発明を実施して形成された 発光装置は様々な電気器具に内蔵され、画素部は映像表 示部として用いられる。本発明の電子装置としては、携 帯電話、PDA、電子書籍、ビデオカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、記録媒体を備えた画像再生装置、例えばDVD (Digital Versatile Disc) プレーヤー、デジタルカメラ、などが挙げられる。それら電子装置の具体例を図1 2、図1 3 に示す。

[0127] 図12(A)は携帯電話であり、乗売用パネル9001、採作用パネル9002、接続第9003 から成り、表示用パネル9001には表示装置9004、寄市出力部9005、アンテナ9009をどが設けられている、操作パネル9002には操作キー9006、電源スイッチ9002、音声入力部9008をどが設けられている、本発明は表示装置9004に適用することができる。

[0128] 図12(B) 熱帯電流であり、本体また は驚や191、表示装置9102、育声出力形の 3、音声入力部9104、アンテナ9105を備えてい る。表示装置9102はタッチ式センサーが目み込ん 、面面上ですン場体ができるようにしても良い、本 発明の有機制能拡射を用いると、表示装置を完成した後 に基板を消曲させることが可能である。このような特性 を生かして、人間工学に差づいて設計されたうろ元的な 曲面を有する筐体にも途和感なく組み入れることができ る。

[0129]図12(C)はモバイルコンピュータ成いは携帯型情報端末であり、本体9201、カメラ第92 02、受機部9203、接体スイッチ9204、表示装置9205で構成されている。本規則は表示装置9205に機能されている。本規則は表示装置9205に適用することができる。このような電子機能には、3インチから5インチクラスの表示装置が用いられるが、本発明の表示装置を用いることにより、携帯型情報 化維木の軽量化を図るとができる。

[0130]図12(D)は携帯書籍であり、本体93 01、表示装置9303配能媒体9304、提作スイッ チ9305、アンテナ9306から積成されており、ミ ニディスク(MD)やDVDに記憶されたデータや、ア ンテナで受信したデータを表示するものである。本処明 は表示装置9302に用いることができる。携帯書籍 は、4インチから12インチクラスの表示装置が用いら れるが、本発明の表示装置を用いることにより、携帯書 編の軽量化と様態化を図ることができる。

【0131】図12(E)はビデオカメラであり、本体 9401、表示装置9402、音声入力部9403、操 作スイッチ9404、バッテリー9405などで構成さ れている。本発明は表示装置9402に適用することが できる。

【0132】図13(A)はパーソナルコンピュータであり、本体9601、画像人力部9602、表示装置9603、キーボード9604で構成される。本発明は表示装置9601に適用することができる。

【0133】図13(B)はプログラムを記録した記録

媒体(以下、記録媒体と呼ぶ)を用いるアレーヤーであり、本体9701、表示装置9702、記述一が部9703、記録媒体9704、提作スイッチ9705で10はされる。なお、この表置は記録媒体としてDVD (Digital Versatile Disc)、CD等を用い、音楽鑑賞や映画鑑賞やゲームやインターネットを行うことができる。本発明は表示表置9702に適用することができる。

【0134】図13(C)はデジタルカメラであり、本 体9801、表示装置9802、接眼部9803、操作 スイッチ9804、受像部(図示しない)で構成され る。本発明は表示装置9802に適用することができ る。

【0135】図13(D)もデジタルカメラであり、本 休9901、表示装置9902、受陰窟903、技作 スイッチ9904、バッテリー9905をどで構成され る。本発明は表示装置9902に適用することができ る。本発明の有限的監禁を用いると、表示装置を完成 たた候に基板を補助させることが可能である。このよう な特性を生かして、人間工学に基づいて設計される3次 元的な価値を有ことがある。

【0136】本発明の表示禁配は図12(A)と(B)の携帯電話、図12(C)のモバイルコンピューク敷い は携帯型精弾端末、図12(D)の携帯電箱、図13 (A)のバーゾナルコンピュータに用い、スタンバイモードにおいて黒色の背景に白色の文字を表示することで機器の消費を通りが表していてある。

【0137】また、図12(A)と(B)で示す練帯電 転換作とおいて、操作キーを使用している時に頭度を下 げ、操作スイッチの使用が挟わったら頭度を上げること で低消費電力化することができる。また、着信した時に 表示裁型の調度を上げ、運治に対理度を下げることによっても低消費電力化することができる。また、鍵部的に 使用している場合に、リセットしない限り時間別的で失 ボがオンになるような機能差件とせることで低消費電力 化を図ることもできる。なお、これらはマニュアル制御 であっても良い。

【0138】図21(A)、(B)は携帯電話であり、 2701は表示用/本ル、2702は排作用/オルであ 。表元用/オルン2701と排作用/オル/2702とは 接続部2703において接続されている。さらに、表示 部2704、音戸出力部2705、接件キー2706、 電源スイッチ2707、音声大力第2708を有している。 本発明は、表示部2704に適用することができ る。左お、(A)は縦型の携帯電話、(B)は模型の携 帯電路を示している。

【0139】また、図21(C)はカーオーディオであり、木体2801、表示部2802、操作スイッチ2803、2804を含む。本発明の発光装置は表示部2802に用いることができる。また、本実施例では車載用

カーオーディオを示すが、据え置き型のカーオーディオ に用いても良い。なお、表示部2804は黒色の背景に 白色の文字を表示することで消費電力を抑えられる。

【0140】さらに、光ンツを内蔵させ、使用環境の明るさを検知する手段を設けることで使用環境の明るさに応じて発光環度を変調させるような機能を持たせることは有効である。使用者は使用環境の明るさに比べてコントラスト比で100~150の明るを確保でされば、回腹ぐへ面積もしくは文字特権を認識できる。即ち、使用環境が明るい場合は画像の頻度を上げて見やすくし、使用環境が暗い場合は画像の頻度を見なて消費電力を卸まるといったことが可能である。

【0141】ここでは図示しなかったが、本発明はその他にもトビゲーションシステムをはじめ冷蔵庫、洗濯 級、電子レンジ、固定電話機、ファクシミリなどに組み 込む表示装置としても適用することも可能である。この ように本発明の適用範囲はきわめて広く、さまさまな製 品に適用することができる。

#### [0142]

【発卵の効果】以上、製卵したように本発明を用いることで、有機樹脂差板を用いた表示装置において、DLC 腰をシール材の外面と有機関語差級の増端または外面に 形成することで、ガスパリア性を高め、発光素干の劣化 を抑えることができる。また、DLC膜を光入射側の表 面に形成しておくことにより、染料線を遮断し、有機樹 脂基板の光化学反応を抑え、その赤化を防ぐことができ

【0143】このような表示装置を用いることで、電子 装置の整量化や耐衡率性が向上する。さらにDLC 限が 形成された表面は硬質であるので、有機制能装板の表面 に偽が付きにくく外限品質を高め、長期間それを維持す ることができる。

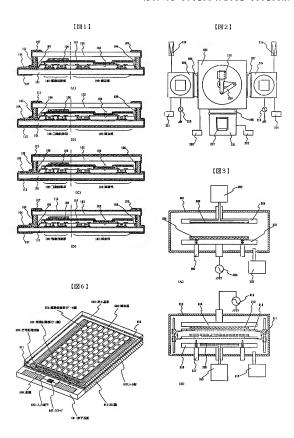
【0144】DLC膜を基板の端面に破膜して関うことで、熊葉や水分が基板間に入り込むのを防ぎ、発光業子 および天光装型の寿命を延ばすことができる。さらに、 発光が変材される領域を除いてDLC膜を設けるため、 膜厚の制御を破壊にする必要がない。また、層面給経験 に無色棚屋と用いることで、第10本板側への光の反射 を防ぐことができるため、腹索者の側が発光接置に映り さむという即程を高値な円備光フィルムを用いることな く解決することができる。

【図面の簡単な説明】

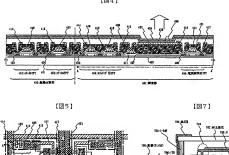
- 【図1】 本発明において有機樹脂基板にDLC膜を形成する場所を説明する図。
- 【図2】 本発明に適用するDLC膜を形成するための プラズマCVD装置の構成を説明する図。
- 【図3】 プラズマCVD装置の反応室の構成を説明する図。
- 【図4】 表示装置の駆動回路と画素部の構成を説明する断面図。
- 【図5】 表示装置の画素部の構成を説明する上面図と 等価回路図
- 寺価凹路区。 【図6】 本発明のEL表示装置の外額を示す斜視図。
- 【図7】 表示装置の入力端子部の構成を説明する図。
- 【図8】 表示装置の入力端子部の構成を説明する図。【図9】 画素部において乾燥剤を設置する場合の一例
- を示す図。
- 【図10】 表示装置の駆動回路と画素部の構成を説明 する断面図。
- 【図11】 表示装置を内蔵する電子装置のシステムブ
- 【図12】 賞子装置の一個を説明する図。
- 【図13】 電子装置の一例を説明する図。
- 【図14】 実施の形態の図。
- 【図15】 本発明のCVD装置の図。
- 【図16】 本発明の実施の形態の一例を示す図。
- 【図17】 本発明の実施の形態の一例を示す図。
- 【図18】 本発明の実施の形態の一例を示す図。
- 【図19】 本発明の実施の形態の一例を示す図。
- 【図20】 本発明の実施の形態の一例を示す図。
- 【図21】 発光装置を表示部に用いた電子器具の一例 を示す図。
- 【図22】 従来例を示す図。
- 【図23】 本発明の実施の形態の一例を示す図。
- 【符号の説明】

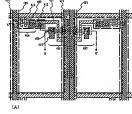
ロック図。

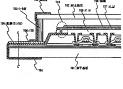
- 101 素子基板
- 102 封止基板 103 発光素子
- 103 充元系丁
- 105 シール材
- 106 乾燥剤
- 107 DLC膜
- 110 隔壁



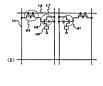
【図4】

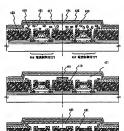


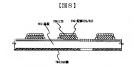




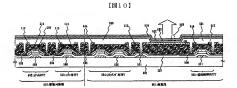
[図9]

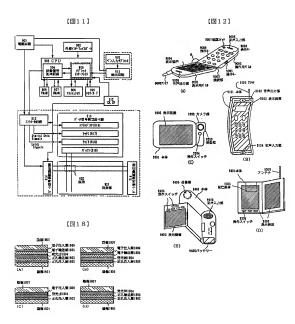


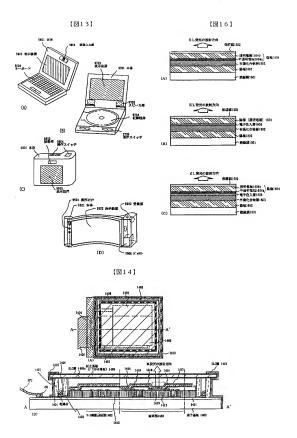




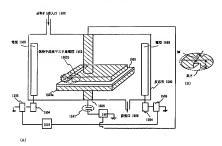


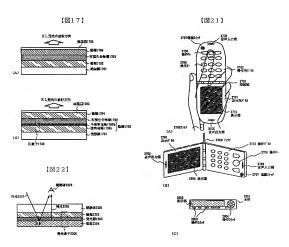




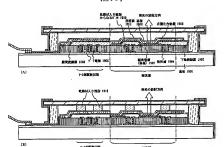


## 【図15】

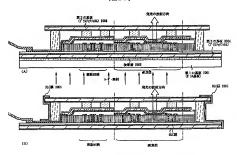


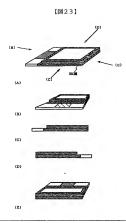


【図19】



【図20】





### フロントページの続き

F ターム (参考) 38007 ABI1 ABI7 ABI8 RAO6 BB05
BB06 BB07 CAO1 CAO6 CB01
CB03 DM01 DB03 EA01 EB00
FA02
5094 ABI1 AAI5 AA31 AA38 AA43
AA48 BA03 BA27 CA19 DB07
DA09 DA12 DA13 DB01 DB04
EA04 EA05 EA07 EA10 EB01
EB02 EB12 FA01 FA06 FB09

FB15 GB10 JA08 JA20